



MOS形電界効果パワートランジスタ MOS Field Effect Power Transistor **25K338**

高耐圧高速度大電流スイッチング用

工業用

High Voltage, High Speed, High Current Switching Industrial Use

2SK338は、高耐圧のNチャネル縦形パワーMOS FETで、スイッチング特性が優れ、また安全動作領域も広く、高周波スイッチングレギュレータ、放電加工機など、大電流高速度スイッチングを必要とする用途に最適です。

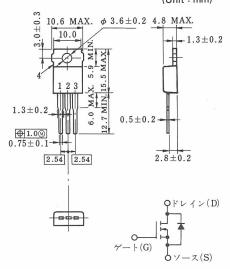
特長/FEATURES

- ○高耐圧, 低オン抵抗 V_{DSS} ≥ 400 V, R_{DS(ON)} ≤ 1.5 Ω
- ○小形モールドパッケージを有する。 TO-220AB
- ○スイッチング特性が優れている。 $t_r \le 50$ ns, $t_f \le 50$ ns @2 A

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25 ℃)

	項	目		略号	条	件	定	格	単位
ドレイン・ソース間電圧				V_{DSS}	$V_{GS} = 0$		400		V
ゲート・ソース間電圧				V _{GSS}	$V_{DS} = 0$		± 20		V
ドレイン電流(直 流)				$I_{D(DC)}$			±5.0		A
ドレイン電流(パルス)			$I_{D(pulse)}$	PW≦10 ms Duty Cycle≦50 %		±7.5		A	
全	損 失		P_T	$T_C=25~^{\circ}C$		40		W	
全	損 失		P_T	$T_a=25$ °C		1.5		W	
チ	ヤネ	ル温	度	T_{ch}			15	0	°C
保	存	温	度	T_{stg}			-55~	+150	°C

外形図/PACKAGE DIMENSIONS



電極接続

- 1. Gate
- 2. Drain(Fin)
- 3. Sourse
- 4. Fin

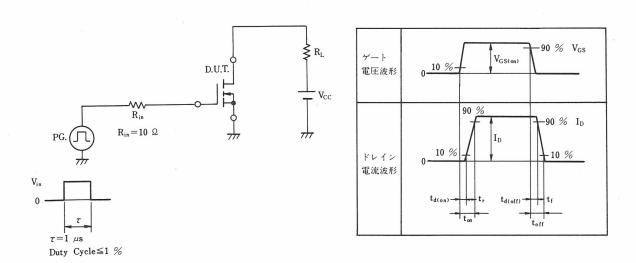
日本電気株式会社



電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
ドレインしゃ断電流	$I_{ exttt{DSS}}$	$V_{DS} = 400 \text{ V}, V_{GS} = 0$			100	μA
ゲート漏れ電流	I _{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}, V_{DS} = 0$			±100	nA
ゲートカットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 10 \text{ V}, I_{D} = 40 \text{ mA}$	1	1.8	5	V
順伝達アドミタンス	y _{fs}	$V_{DS}=10$ V, $I_{D}=2$ A	1			S
ドレイン・ソース間オン抵抗	R _{DS(ON)}	$V_{GS}=10$ V, $I_D=2$ A			1.5	Ω
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS} = 10 \text{ V}, V_{GS} = 0$ f = 1 MHz		600	2000	pF
出 力 容 量	Coss			150	300	pF
帰 還 容 量	C_{rss}			20	50	pF
オン時遅延時間	t _{d(on)}			10	50	ns
立 上 り 時 間	t _r	$I_D=2$ A, $V_{GS(on)}=10$ V $V_{CC} = 150$ V, $R_L=75$ Ω		40	100	ns
オフ時遅延時間	t _{d(off)}	$\begin{bmatrix} v_{CC} = 150 & v, & R_L = 75 & \Omega \\ R_{in} = 10 & \Omega & \end{bmatrix}$		15	50	ns
下 降 時 間	t _f			20	50	ns

スイッチングタイム測定回路,測定条件(抵抗負荷)

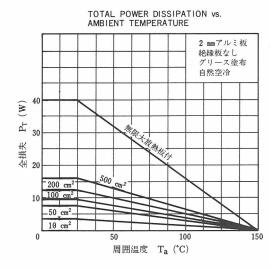


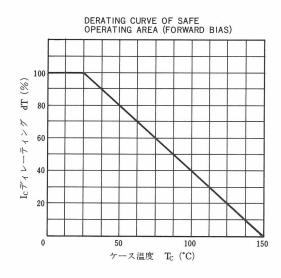
取扱い時の注意事項

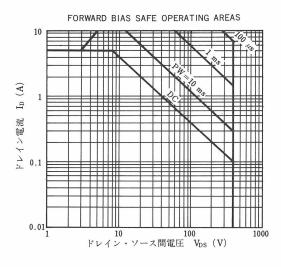
MOS構造であり、ゲートは薄い酸化膜で絶縁されており、かつ保護ダイオードを内蔵していないため、静電破壊に弱く、取り扱い時の静電気には充分注意が必要です。



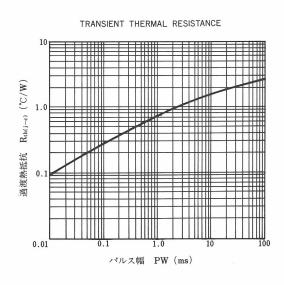
特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

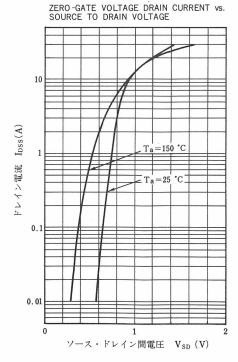












0.01

0

100

200

ドレイン・ソース間電圧 V_{DS} (V)

300

400



DRAIN LEAK CURRENT vs.
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE

Teh=150 °C

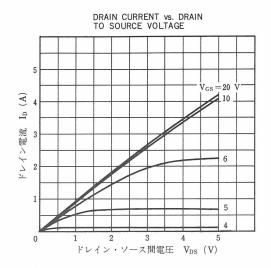
10

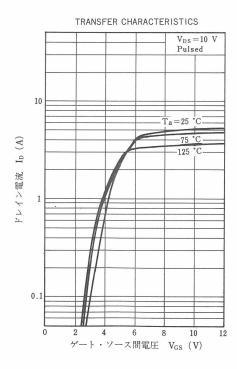
125 °C

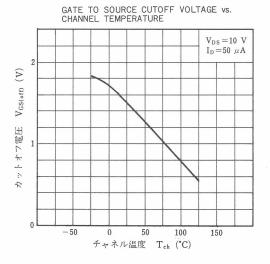
100 °C

75 °C

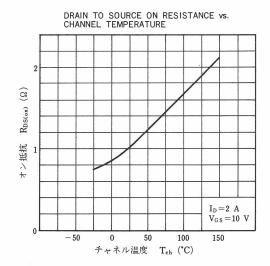
50 °C

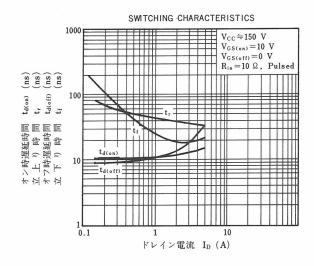














NEC 日本電気株式会社